

텍사스 인스트루먼트:

텍사스주 리처드슨에서 반도체 제조의 새로운 시대를 구축합니다

제조 역량 구축

- TI의 세 번째 팹이자 최대 규모의 300mm 웨이퍼 팹인 RFAB2가 **첫 생산**을 시작했습니다.
- RFAB2는 2010년에 세계 최초의 300mm 아날로그 웨이퍼 팹으로 성장한 RFAB1과 **연결**되어 있습니다.

첨단 제조 시설 구축

- **58,000 평방미터 이상**의 결합된 청결한 실내 공간
- 팹 간에 웨이퍼를 원활하게 이동하는 **24km 이상**의 자동화된 오버헤드 트랙
- 완전한 생산 환경에서 RFAB1 및 RFAB2는 매일 **1억 개 이상**의 아날로그 칩을 생산하며 이는 전 세계의 전자 제품에 사용됩니다.

지속 가능한 미래 구축

- **책임감 있고 지속 가능한 제조** 공정을 위한 오랜 노력
- RFAB2는 **LEED Gold** 표준을 충족하도록 설계되었습니다. RFAB1은 **세계 최초로 LEED Gold** 인증을 받은 아날로그 반도체 제조 시설입니다.

강력한 커뮤니티 구축

- 텍사스 북부에서 **90년 이상**
- 2010년부터 텍사스 북부 커뮤니티에 **수억 달러** 투자

